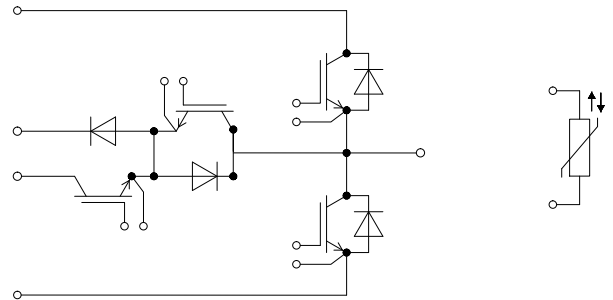
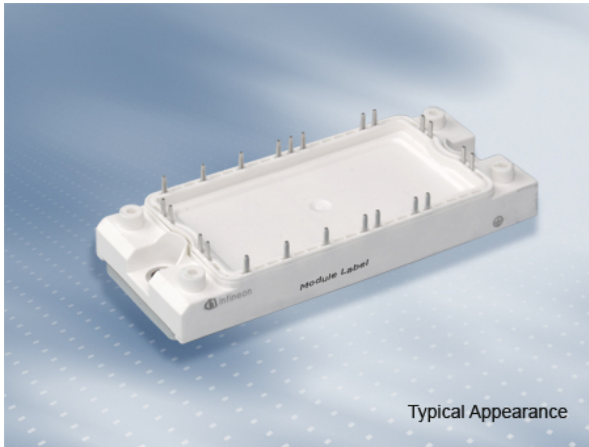


EconoPACK™2 Modul mit aktiver "Neutral Point Clamp 2" Topologie und NTC
 EconoPACK™2 module with active "Neutral Point Clamp 2" topology and NTC



$V_{CES} = 1200V$
 $I_{C\ nom} = 150A / I_{CRM} = 300A$

Potentielle Anwendungen

- 3-Level-Applikationen
- Motorantriebe
- Solar Anwendungen
- USV-Systeme

Elektrische Eigenschaften

- High Speed IGBT H3
- Niedrige Schaltverluste
- $T_{vj\ op} = 150^{\circ}C$

Mechanische Eigenschaften

- 2,5 kV AC 1min Isolationsfestigkeit
- Lötverbindungstechnik
- RoHS konform

Potential Applications

- 3-level-applications
- Motor drives
- Solar applications
- UPS systems

Electrical Features

- High speed IGBT H3
- Low switching losses
- $T_{vj\ op} = 150^{\circ}C$

Mechanical Features

- 2.5 kV AC 1min insulation
- Solder contact technology
- RoHS compliant

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

IGBT, Wechselrichter / IGBT, Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
Implementierter Kollektor-Strom Implemented collector current		I_{CN}	200	A
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	I_{CDC}	150	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{CRM}	400	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

		min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 150\text{ A}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	1,80 2,10 2,20	2,15 V V V
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	$I_C = 7,60\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		V_{GETH}	5,25	5,80, 6,35 V
Gateladung Gate charge	$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, V_{CE} = 350\text{ V}$		Q_G	1,60	μC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{Gint}	3,8	Ω
Eingangskapazität Input capacitance	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{ies}	11,5	nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{res}	0,63	nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{CES}		1,0 mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{GES}		100 nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 2,4\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{don}	0,19 0,20 0,20	μs μs μs
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 2,4\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_r	0,044 0,052 0,053	μs μs μs
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 2,4\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{doff}	0,31 0,39 0,40	μs μs μs
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 2,4\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_f	0,04 0,10 0,12	μs μs μs
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}, L\sigma = 35\text{ nH}$ $di/dt = 2900\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, R_{Gon} = 2,4\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{on}	3,00 4,90 5,30	mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}, L\sigma = 35\text{ nH}$ $du/dt = 2800\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, R_{Goff} = 2,4\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{off}	4,55 6,95 7,70	mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V}$ $V_{CE\max} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		I_{SC}	720	A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro IGBT / per IGBT		R_{thJC}		0,162 K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}		0,111 K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	150 $^{\circ}\text{C}$

Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F	100	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	200	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	1950 1850	A^2s A^2s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

		min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$I_F = 100\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		1,75	2,15	V
	$I_F = 100\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		1,70		V
	$I_F = 100\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		1,70		V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	$I_F = 100\text{ A}, -di_F/dt = 2600\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		102		A
	$V_R = 350\text{ V}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		123		A
	$V_{GE} = -15\text{ V}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		128		A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_F = 100\text{ A}, -di_F/dt = 2600\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		7,50		μC
	$V_R = 350\text{ V}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		13,6		μC
	$V_{GE} = -15\text{ V}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		15,5		μC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_F = 100\text{ A}, -di_F/dt = 2600\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		2,00		mJ
	$V_R = 350\text{ V}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		3,80		mJ
	$V_{GE} = -15\text{ V}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		4,35		mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode	R_{thJC}		0,491	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	R_{thCH}	0,146		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{vj\text{ op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

IGBT,3-Level / IGBT,3-Level

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	650	V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	$T_C = 50^{\circ}\text{C}, T_{vj\text{ max}} = 175^{\circ}\text{C}$	I_{CDC}	150	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{CRM}	300	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.		
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 150\text{ A}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	1,45 1,60 1,70	1,90	V V V	
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	$I_C = 2,40\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		V_{GEth}	5,05	5,80	6,45	V
Gateladung Gate charge	$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$		Q_G	1,50		μC	
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{Gint}	2,0		Ω	
Eingangskapazität Input capacitance	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{ies}	9,30		nF	
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{res}	0,285		nF	
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 650\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{CES}		1,0	mA	
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{GES}		100	nA	
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 3,3\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{don}	0,08 0,10 0,10		μs μs μs	
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 3,3\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_r	0,051 0,057 0,062		μs μs μs	
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 3,3\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{doff}	0,29 0,32 0,34		μs μs μs	
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 3,3\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_f	0,07 0,12 0,14		μs μs μs	
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}, L\sigma = 35\text{ nH}$ $di/dt = 2800\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, R_{Gon} = 3,3\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{on}	7,20 9,45 10,0		mJ mJ mJ	
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}, L\sigma = 35\text{ nH}$ $du/dt = 4000\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, R_{Goff} = 3,3\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{off}	4,50 6,40 7,00		mJ mJ mJ	
Kurzschlußverhalten SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 360\text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 6\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		I_{SC}	750		A	
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro IGBT / per IGBT		R_{thJC}		0,349	K/W	
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}	0,138		K/W	
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$	

Diode, 3-Level / Diode, 3-Level

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	650	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F	150	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	300	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	1700 1650	A^2s A^2s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$I_F = 150\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 150\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 150\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	V_F	1,65 1,55 1,50	2,15	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	$I_F = 150\text{ A}, -di_F/dt = 2900\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{RM}	69,0 89,0 95,0		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_F = 150\text{ A}, -di_F/dt = 2900\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	Q_r	4,40 8,10 9,50		μC μC μC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_F = 150\text{ A}, -di_F/dt = 2900\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{rec}	1,15 1,90 2,20		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode		R_{thJC}		0,645	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}	0,154		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

NTC-Widerstand / NTC-Thermistor

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand Rated resistance	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{25}	5,00		$\text{k}\Omega$
Abweichung von R100 Deviation of R100	$T_{NTC} = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493\ \Omega$		$\Delta R/R$	-5	5	%
Verlustleistung Power dissipation	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$		P_{25}		20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		$B_{25/50}$	3375		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		$B_{25/80}$	3411		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		$B_{25/100}$	3433		K

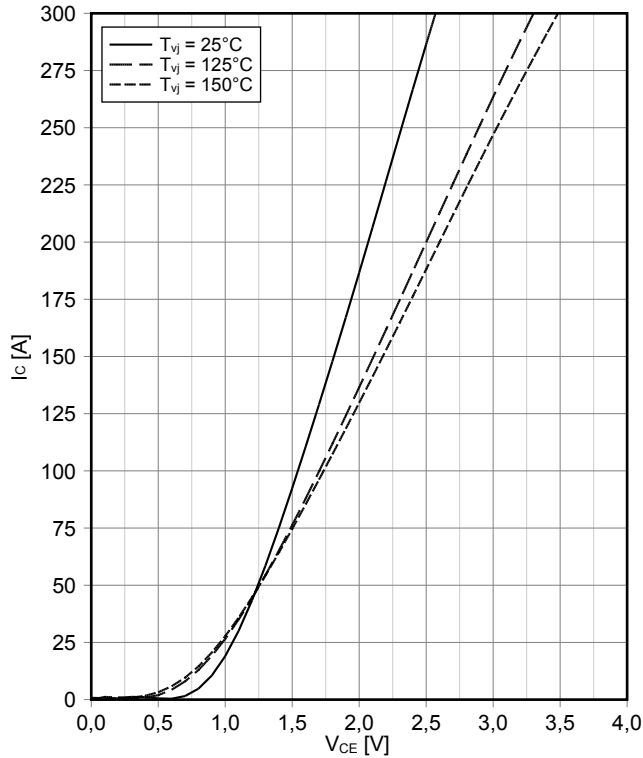
Angaben gemäß gültiger Application Note.
Specification according to the valid application note.

Modul / Module

Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}	2,5		kV
Material Modulgrundplatte Material of module baseplate			Cu		
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		Al ₂ O ₃		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		10,0		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		7,5		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI	> 200		
			min.	typ.	max.
Modulstreuinduktivität Stray inductance module		L _{sCE}		17	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T _C = 25°C, pro Schalter / per switch	R _{CC'+EE'}		2,50	mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T _{stg}	-40		125 °C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting	Schraube - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw - Mounting according to valid application note	M	3,00		6,00 Nm
Gewicht Weight		G		180	g

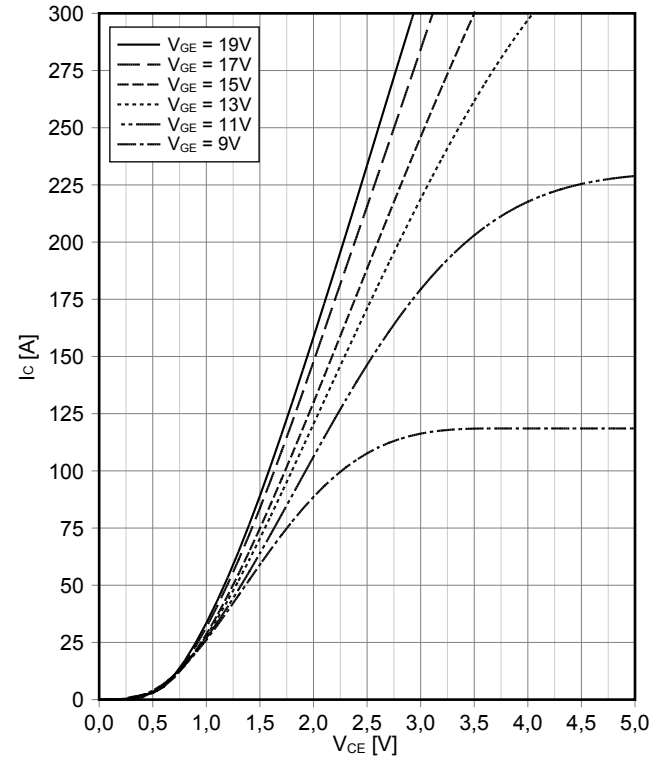
Ausgangskennlinie IGBT, Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



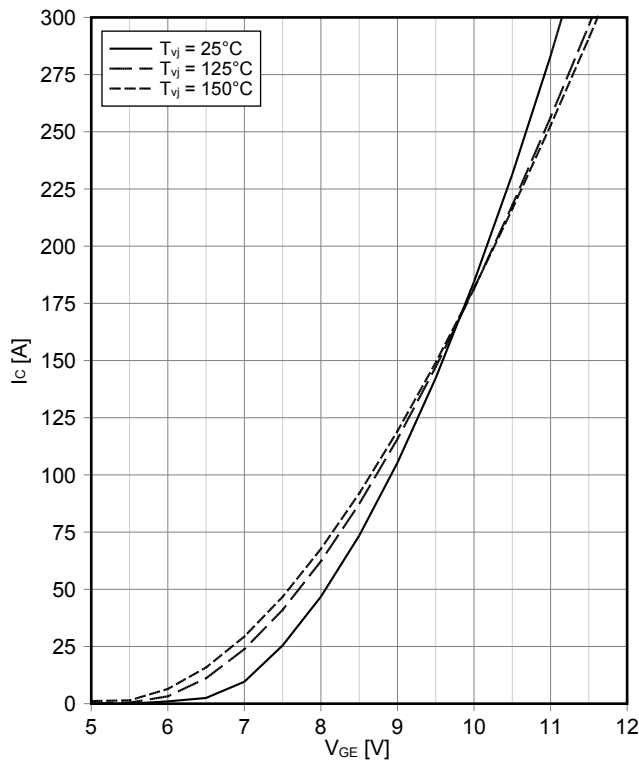
Ausgangskennlinienfeld IGBT, Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



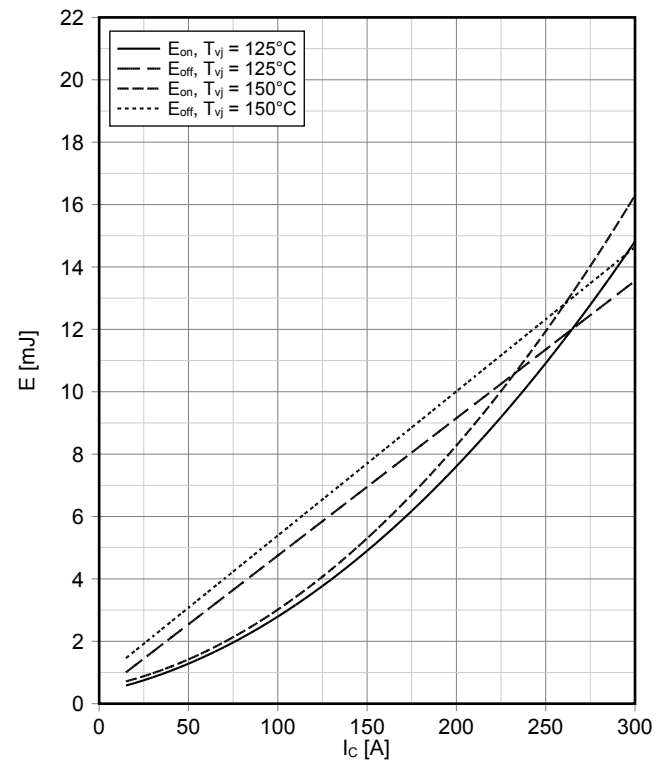
Übertragungscharakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch)
transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



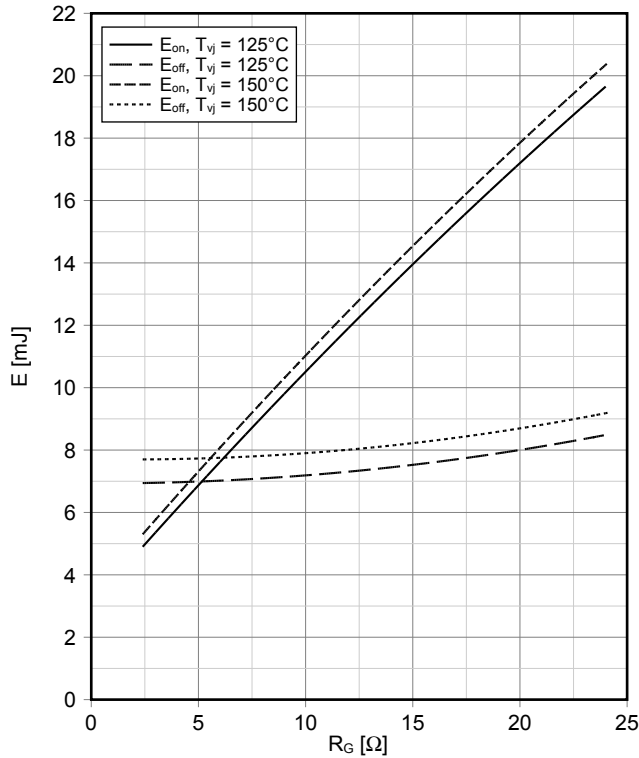
Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 2.4\ \Omega$, $R_{Goff} = 2.4\ \Omega$, $V_{CE} = 350\text{ V}$



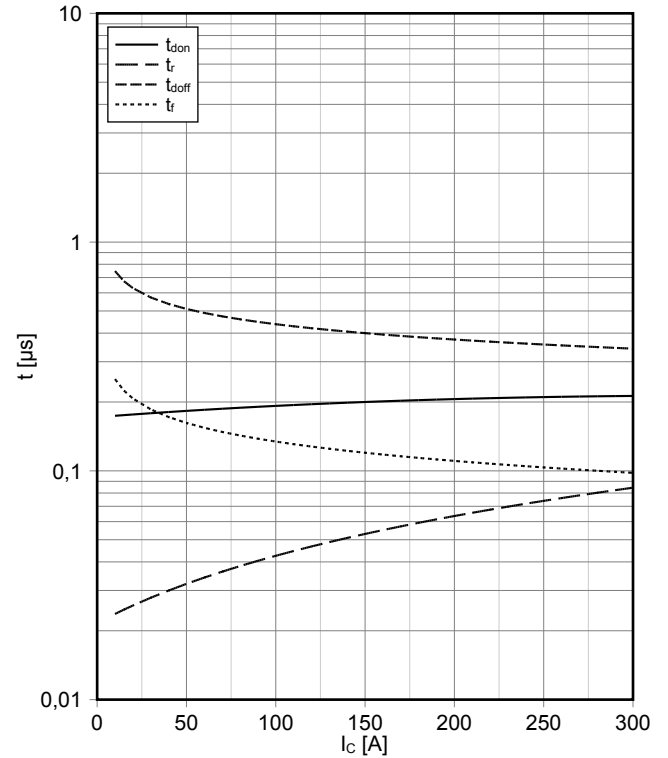
Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15 V, I_C = 150 A, V_{CE} = 350 V$



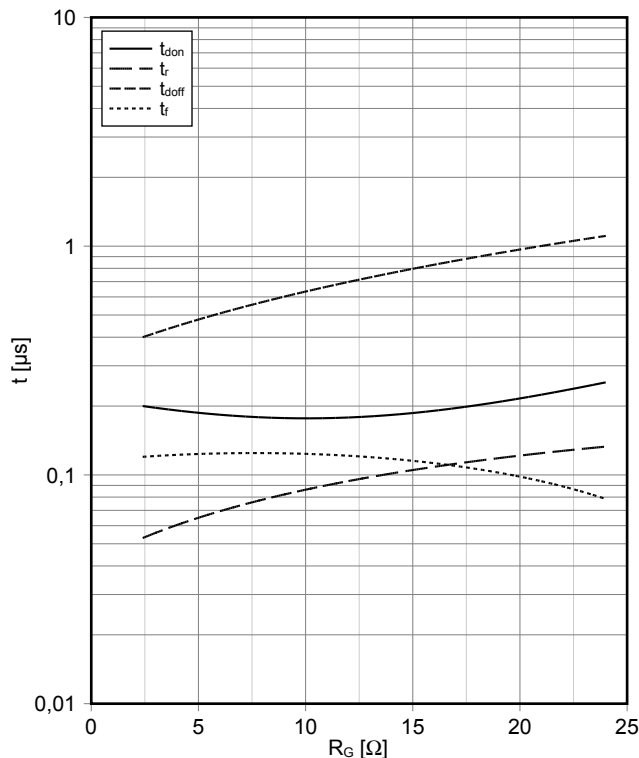
Schaltzeiten IGBT, Wechselrichter (typisch)
switching times IGBT, Inverter (typical)

$t_{don} = f(I_C), t_r = f(I_C), t_{doff} = f(I_C), t_f = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15 V, R_{Gon} = 2.4 \Omega, R_{Goff} = 2.4 \Omega, V_{CE} = 350 V, T_{vj} = 150^\circ C$



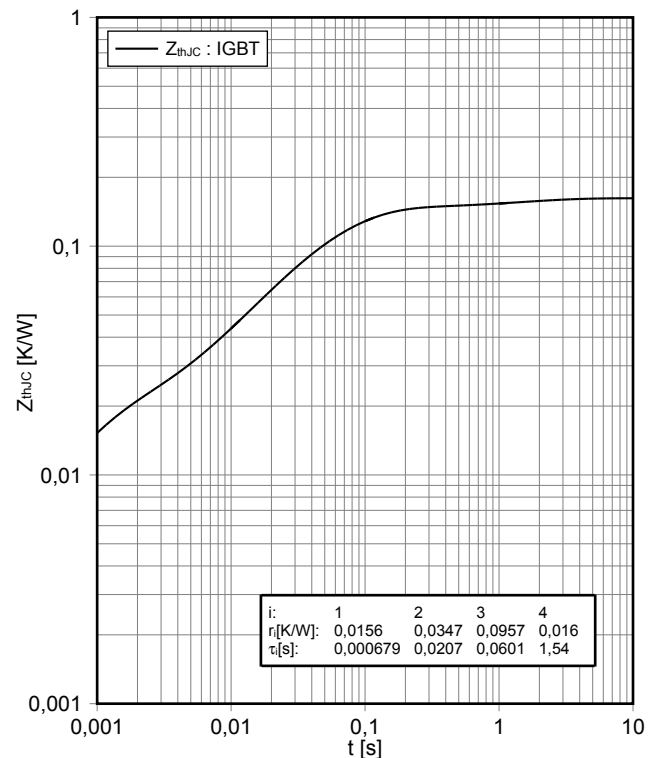
Schaltzeiten IGBT, Wechselrichter (typisch)
switching times IGBT, Inverter (typical)

$t_{don} = f(R_G), t_r = f(R_G), t_{doff} = f(R_G), t_f = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15 V, I_C = 150 A, V_{CE} = 350 V, T_{vj} = 150^\circ C$



Transienter Wärmewiderstand IGBT, Wechselrichter
transient thermal impedance IGBT, Inverter

$Z_{thJC} = f(t)$

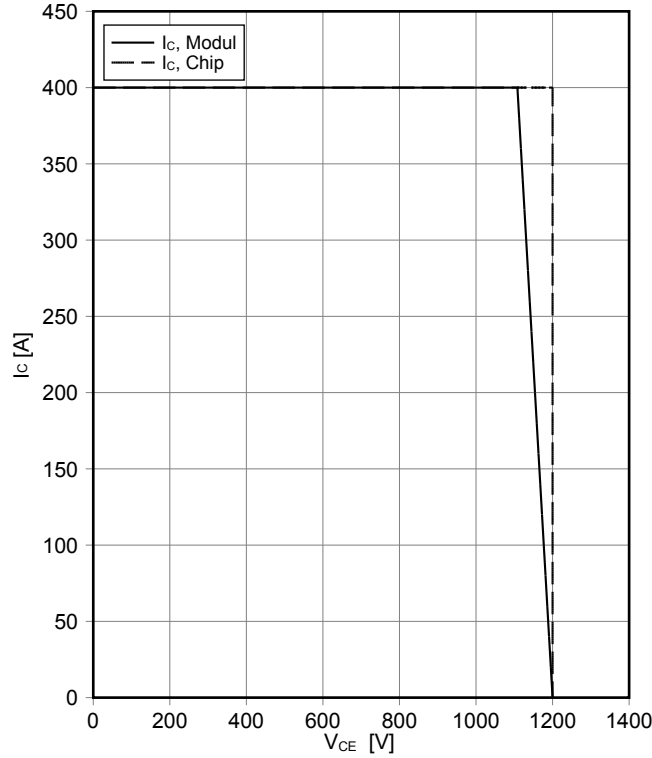


Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT, Wechselrichter (RBSOA)

reverse bias safe operating area IGBT, Inverter (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 2.4\ \Omega$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

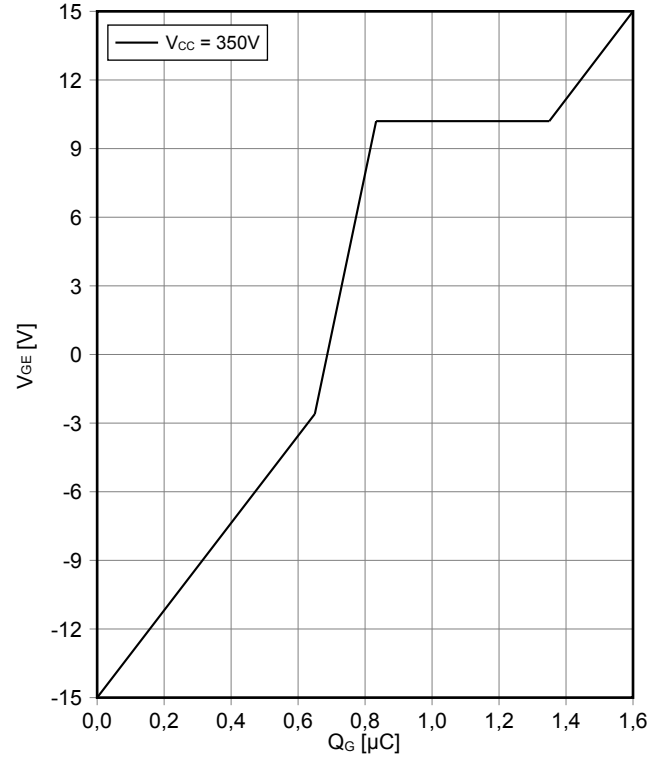


Gateladungs Charakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch)

gate charge characteristic IGBT, Inverter (typical)

$V_{GE} = f(Q_G)$

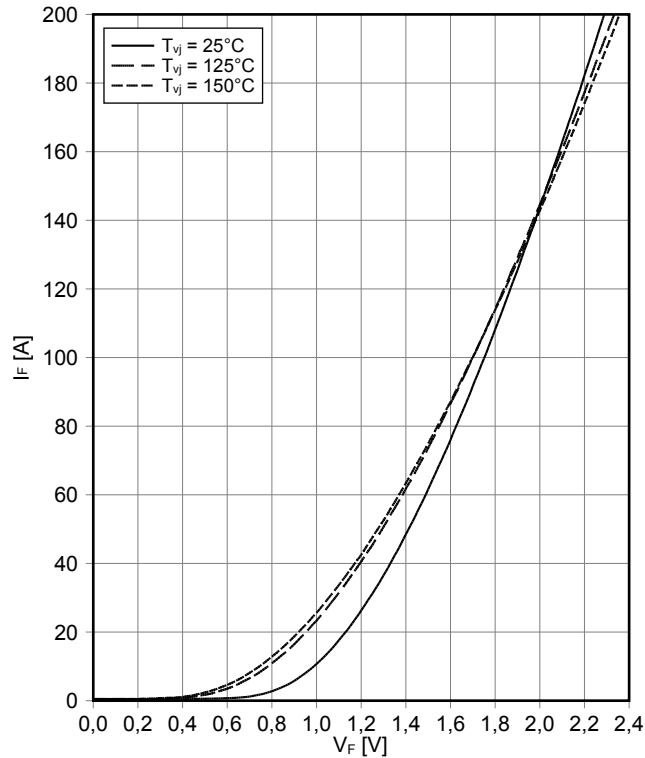
$I_C = 150\text{ A}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$



Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)

forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

$I_F = f(V_F)$

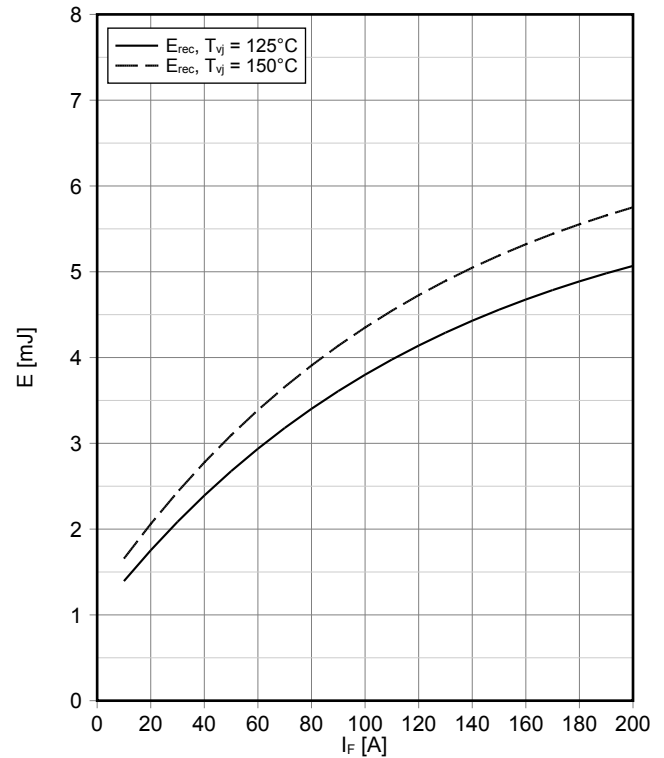


Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)

switching losses Diode, Inverter (typical)

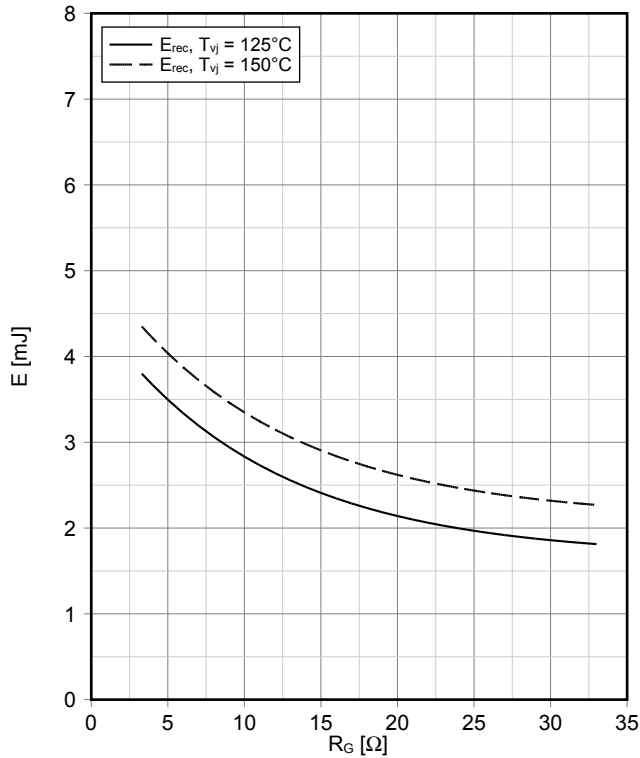
$E_{rec} = f(I_F)$

$R_{Gon} = 3.3\ \Omega$, $V_{CE} = 350\text{ V}$



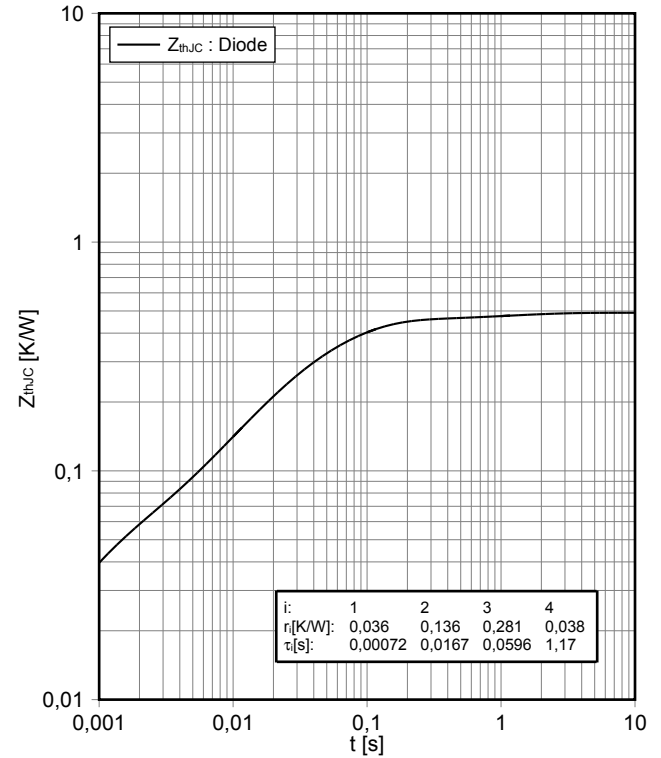
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode, Inverter (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 100\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$



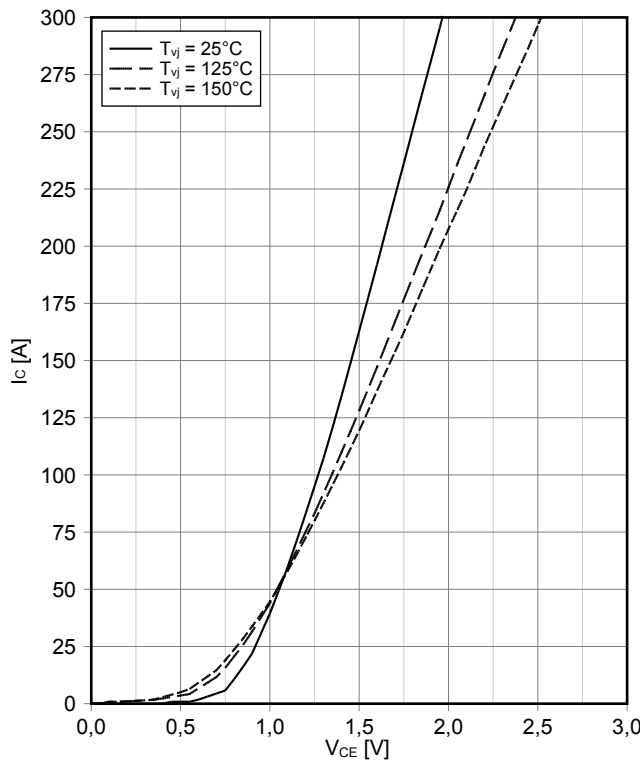
Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter
transient thermal impedance Diode, Inverter

$Z_{thJC} = f(t)$



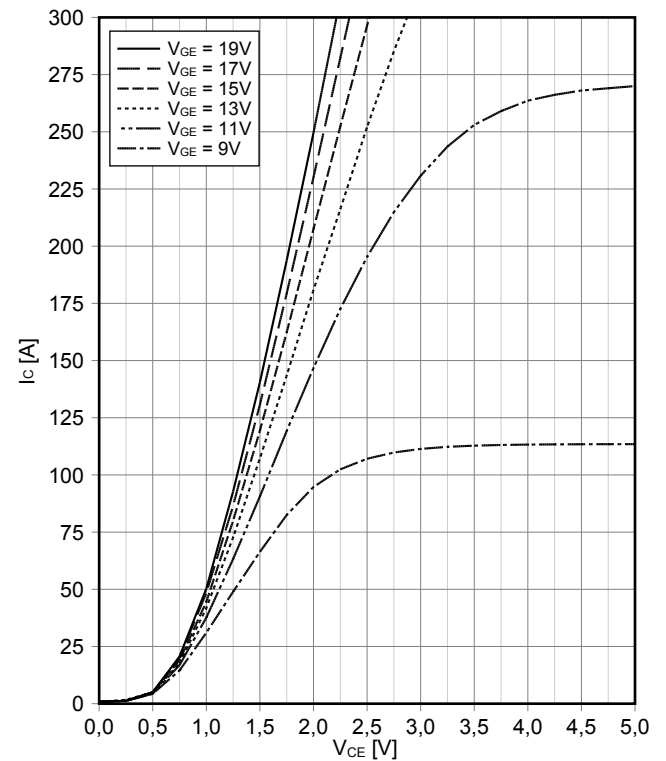
Ausgangskennlinie IGBT,3-Level (typisch)
output characteristic IGBT,3-Level (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



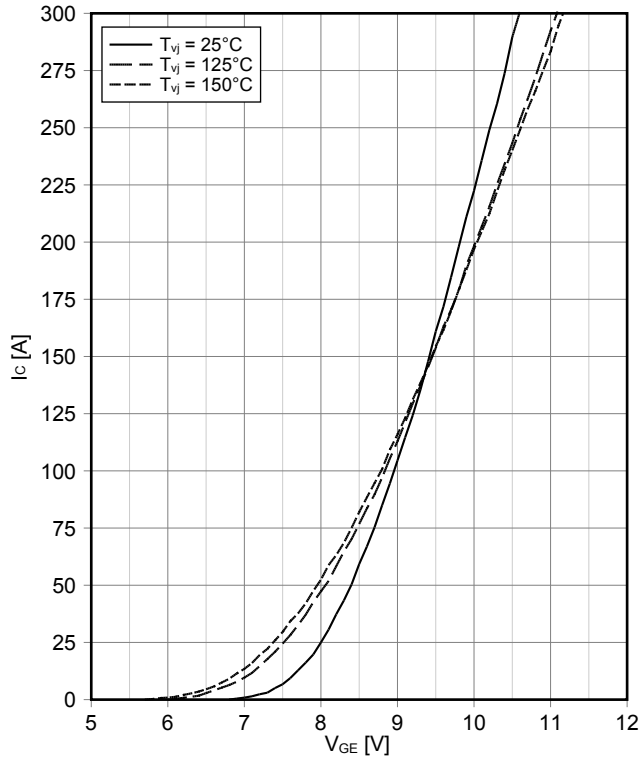
Ausgangskennlinienfeld IGBT,3-Level (typisch)
output characteristic IGBT,3-Level (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



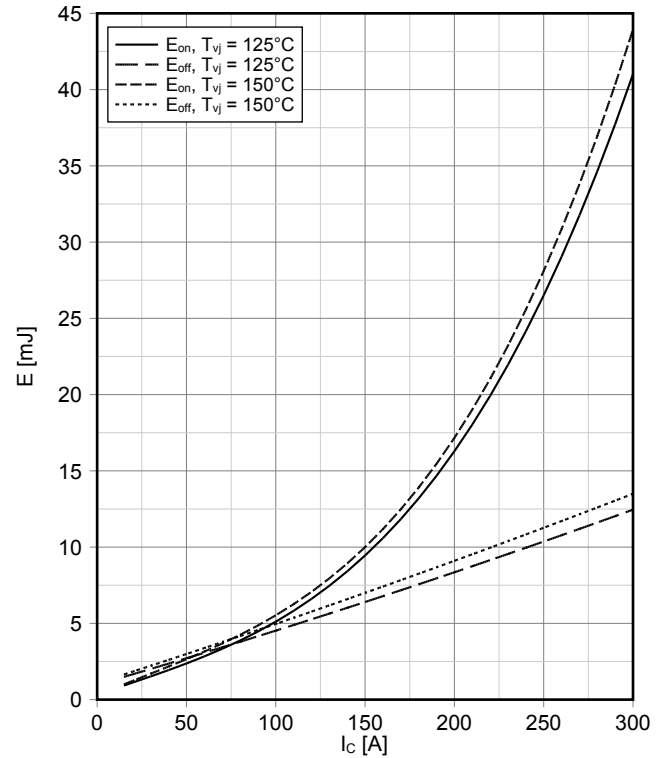
Übertragungscharakteristik IGBT,3-Level (typisch)
transfer characteristic IGBT,3-Level (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



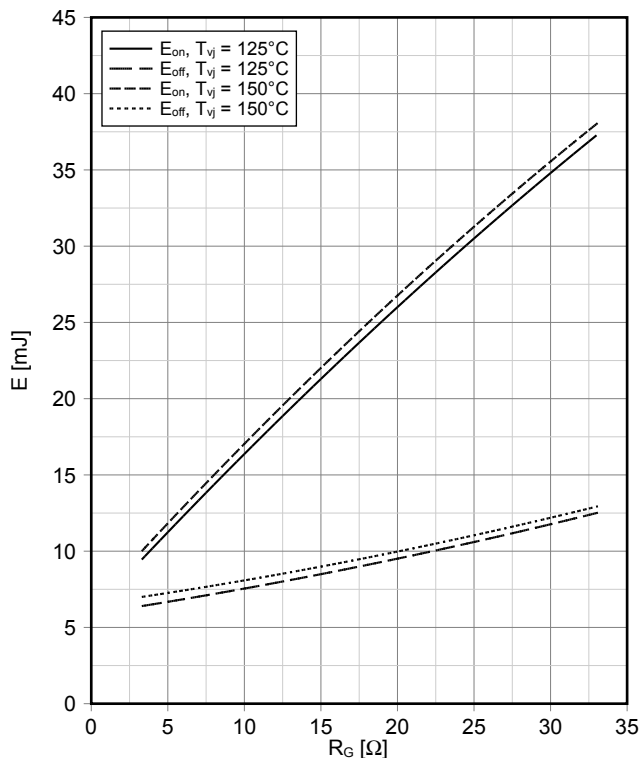
Schaltverluste IGBT,3-Level (typisch)
switching losses IGBT,3-Level (typical)

$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 3.3\ \Omega, R_{Goff} = 3.3\ \Omega, V_{CE} = 350\text{ V}$



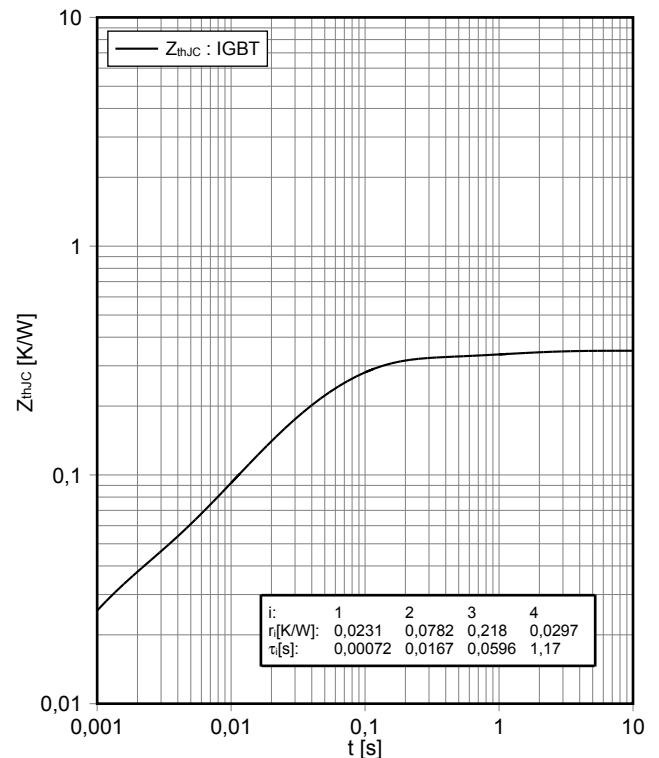
Schaltverluste IGBT,3-Level (typisch)
switching losses IGBT,3-Level (typical)

$E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, I_C = 150\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$



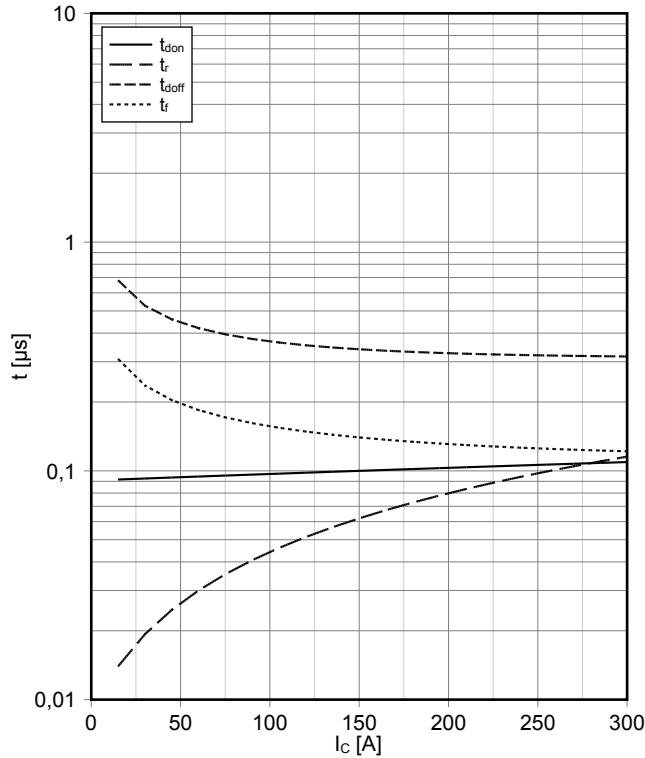
Transienter Wärmewiderstand IGBT,3-Level
transient thermal impedance IGBT,3-Level

$Z_{thJC} = f(t)$



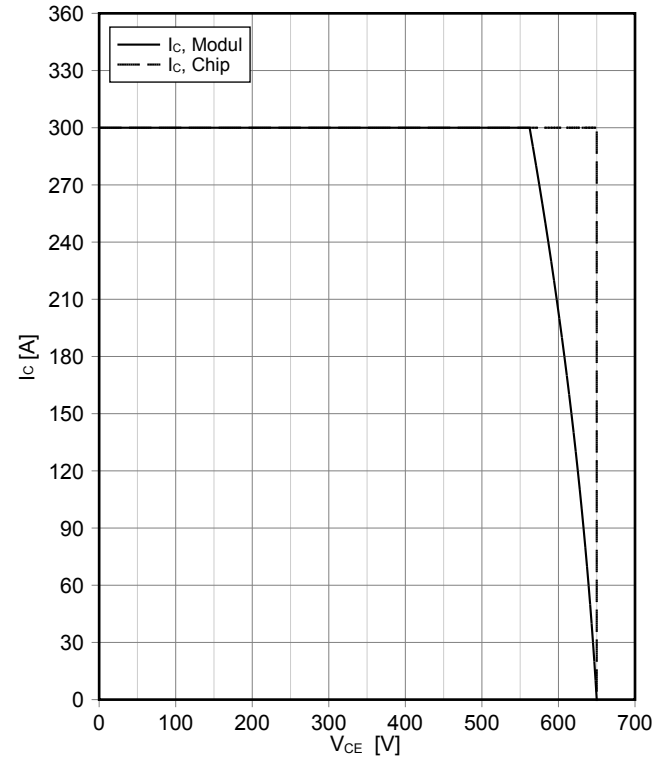
Schaltzeiten IGBT,3-Level (typisch) switching times IGBT,3-Level (typical)

$t_{don} = f(I_C)$, $t_r = f(I_C)$, $t_{doff} = f(I_C)$, $t_f = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 3.3\ \Omega$, $R_{Goff} = 3.3\ \Omega$, $V_{CE} = 350\text{ V}$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



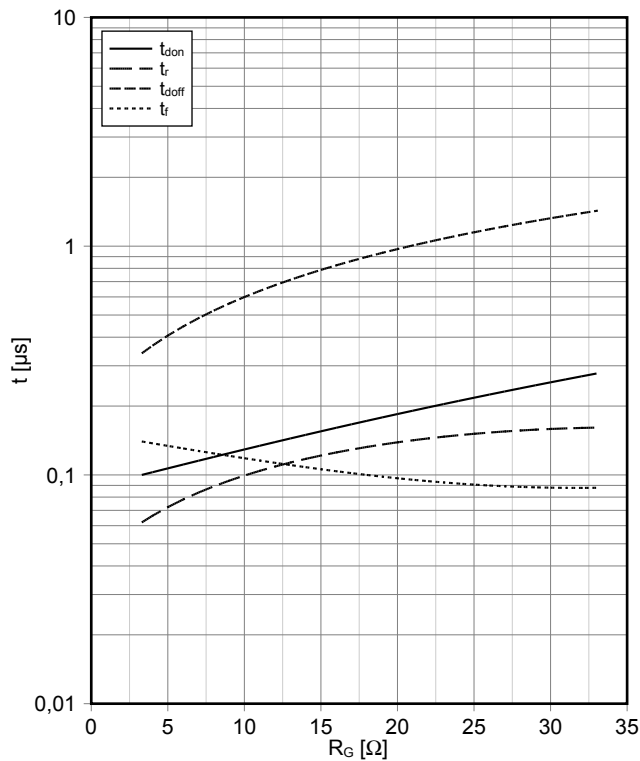
Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT,3-Level (RBSOA) reverse bias safe operating area IGBT,3-Level (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 3.3\ \Omega$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



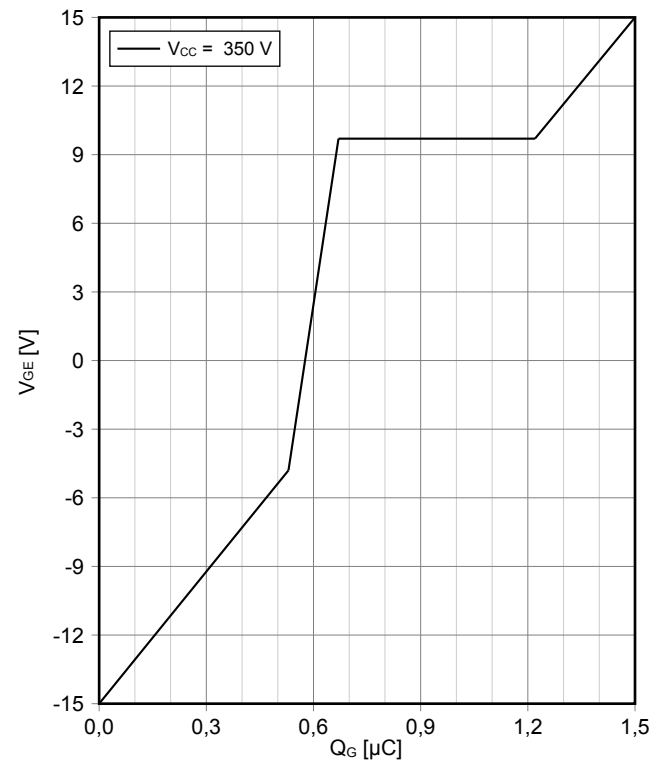
Schaltzeiten IGBT,3-Level (typisch) switching times IGBT,3-Level (typical)

$t_{don} = f(R_G)$, $t_r = f(R_G)$, $t_{doff} = f(R_G)$, $t_f = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 150\text{ A}$, $V_{CE} = 350\text{ V}$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

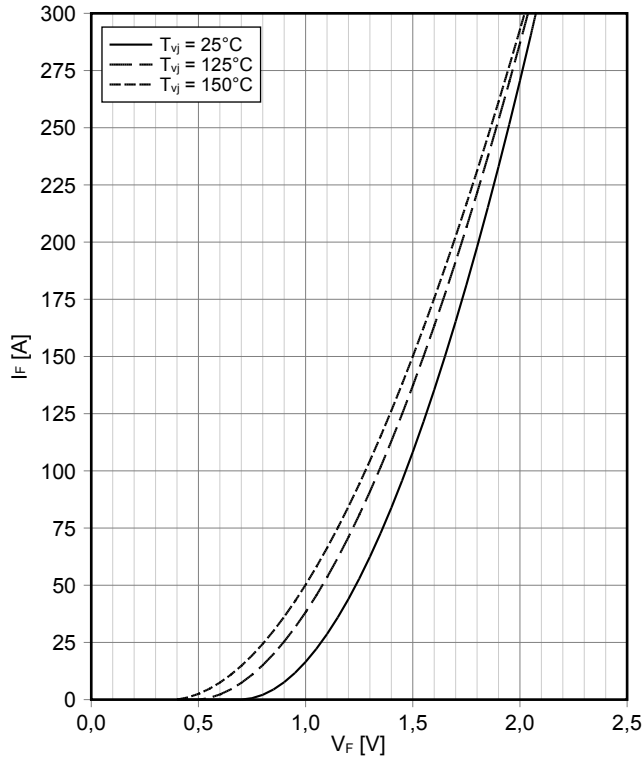


Gateladungs Charakteristik IGBT,3-Level (typisch) gate charge characteristic IGBT,3-Level (typical)

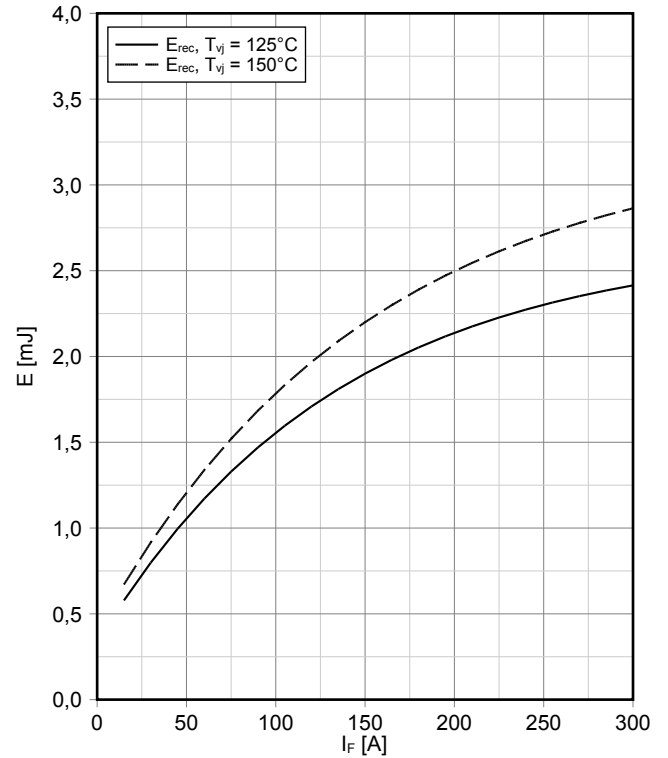
$V_{GE} = f(Q_G)$
 $I_C = 150\text{ A}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$



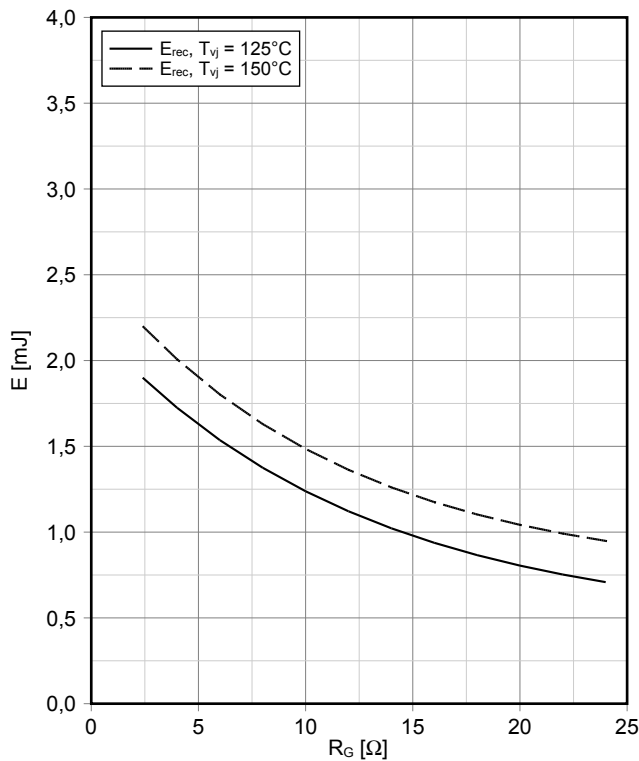
Durchlasskennlinie der Diode, 3-Level (typisch)
forward characteristic of Diode, 3-Level (typical)
 $I_F = f(V_F)$



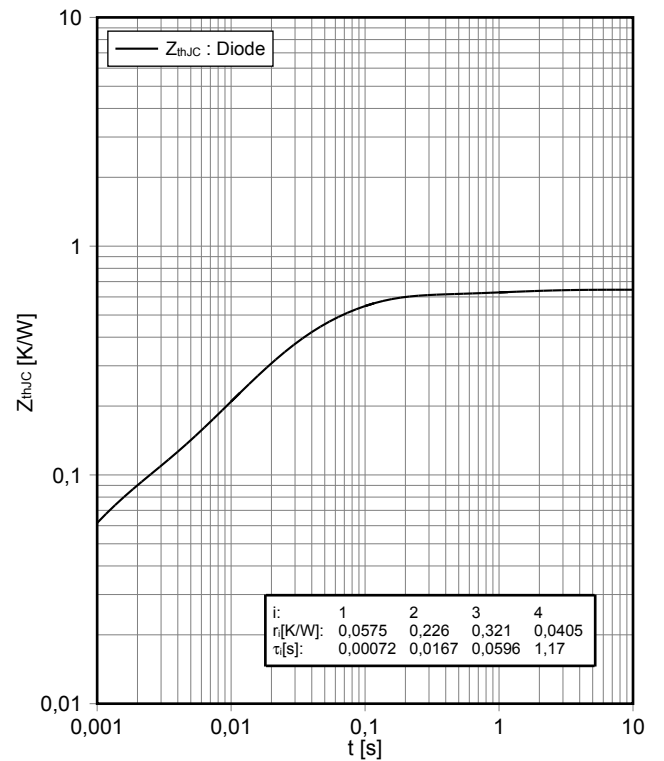
Schaltverluste Diode, 3-Level (typisch)
switching losses Diode, 3-Level (typical)
 $E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 2.4 \Omega, V_{CE} = 350 \text{ V}$



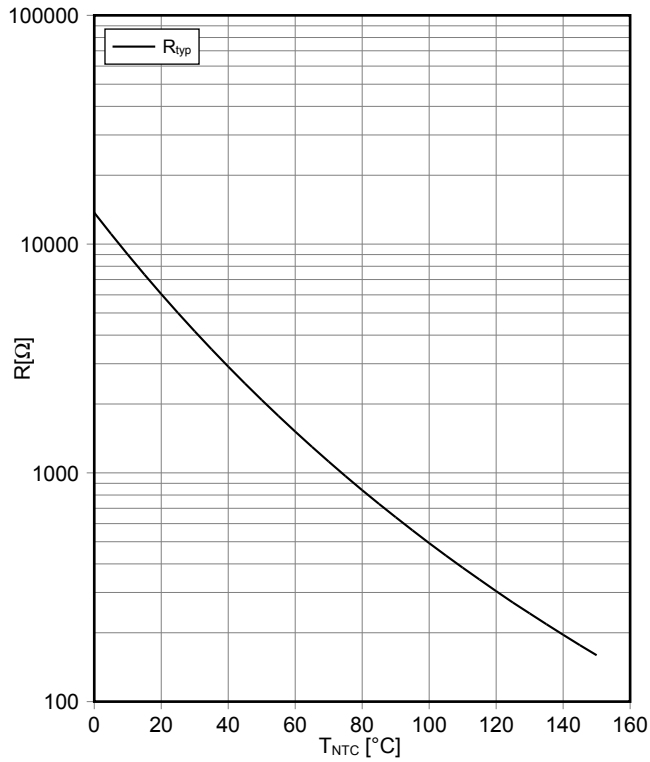
Schaltverluste Diode, 3-Level (typisch)
switching losses Diode, 3-Level (typical)
 $E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 150 \text{ A}, V_{CE} = 350 \text{ V}$



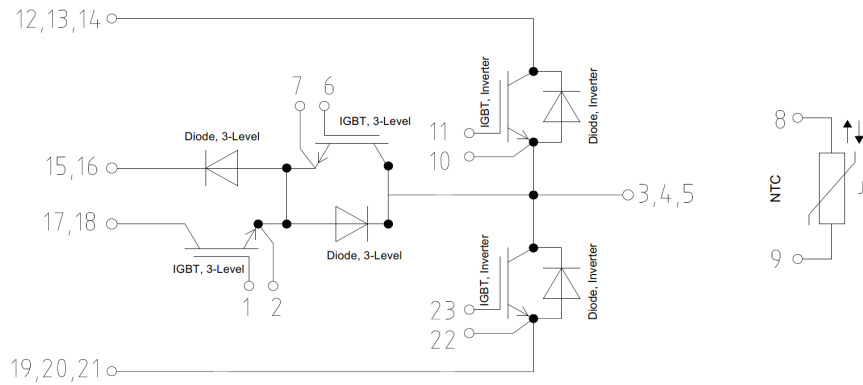
Transienter Wärmewiderstand Diode, 3-Level
transient thermal impedance Diode, 3-Level
 $Z_{thJC} = f(t)$



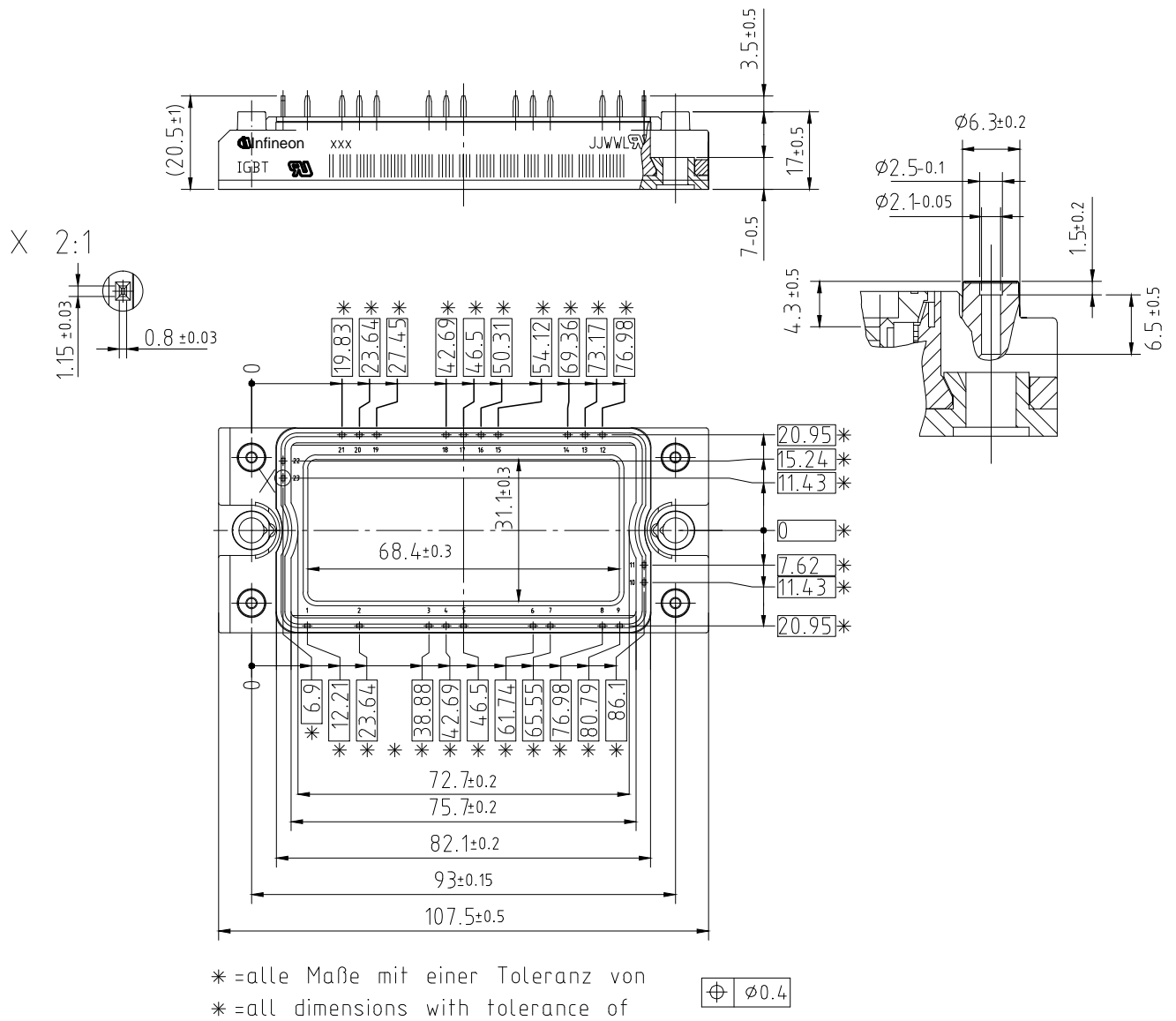
NTC-Widerstand-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)
 $R = f(T)$



Schaltplan / Circuit diagram



Gehäuseabmessungen / Package outlines



Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2018-06-29

Published by
Infineon Technologies AG
81726 München, Germany

© 2018 Infineon Technologies AG.
All Rights Reserved.

Do you have a question about this document?
Email: erratum@infineon.com

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar. Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Sollten Sie von uns weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Produkt, der Technologie, Lieferbedingungen bzw. Preisen benötigen, wenden Sie sich bitte an das nächste Vertriebsbüro von Infineon Technologies (www.infineon.com).

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.

IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Infineon\(英飞凌\)](#)